

# DTA1D3RE/DTA1D3RUA/DTA1D3RKA

デジタルトランジスタ（抵抗内蔵トランジスタ）

Digital Transistors (Includes Resistors)

トランジスタスイッチ/Transistor Switch

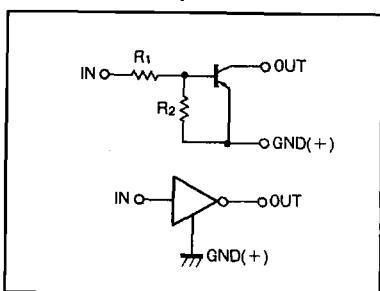
● 特長

- 1) バイアス用の抵抗を内蔵しているため、入力側の外付け抵抗なしでインバータ回路が構成できる（等価回路図参照）。
- 2) バイアス用の抵抗は、薄膜抵抗により構成し、完全にアイソレーションしているため、入力を正にバイアスできる。また、寄生効果がほとんど生じないという利点がある。
- 3) ON-OFF 条件の設定だけで動作するため、機器の設計が容易に行える。
- 4) 実装密度の向上を図ることができる。

● Features

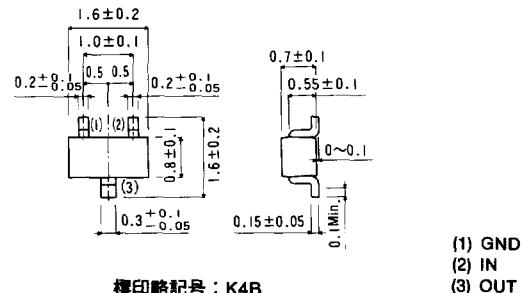
- 1) A built-in bias resistor allow inverter circuit configuration without external resistors for input (see equivalent circuit diagram).
- 2) The bias resistor consists of a thin-film resistor which is completely isolated, providing the capability to positive-bias the input, and avoiding parasitic effects.
- 3) Operation starts by simply setting On/Off conditions, simplifying the design of equipment using the transistor.
- 4) High packing density.

● 等価回路図／Equivalent Circuit



● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)

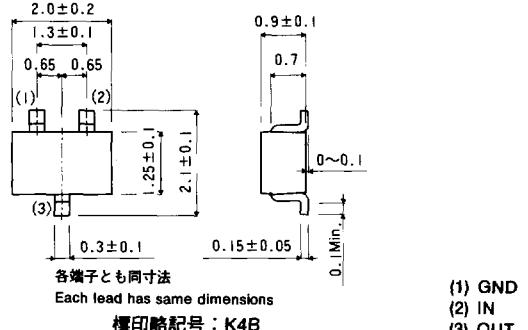
**DTA1D3RE**



ROHM : EM3

(1) GND  
(2) IN  
(3) OUT

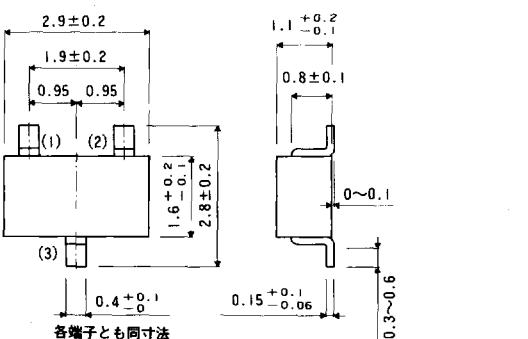
**DTA1D3RU**



ROHM : UMT  
EIAJ : SC-70

(1) GND  
(2) IN  
(3) OUT

**DTA1D3RK**



ROHM : SMT  
EIAJ : SC-59

(1) GND  
(2) IN  
(3) OUT

## ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits (DTA1D3R-)		Unit
		E	U/K	
電源電圧	V <sub>CC</sub>	-50		V
入力電圧	V <sub>I</sub>	-15		V
		15		V
出力電流	I <sub>O</sub>	-700		mA
	I <sub>Cmax</sub>	-100		mA
許容損失	P <sub>d</sub>	150	200	mW
接合部温度	T <sub>J</sub>	150		°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-55~150		°C

## ● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	V <sub>I</sub> (off)	—	—	-1.5	V	V <sub>CC</sub> =-5V, I <sub>O</sub> =-100 μA
	V <sub>I</sub> (on)	-4.0	—	—	V	V <sub>O</sub> =-0.3V, I <sub>O</sub> =-5mA
出力電圧	V <sub>O</sub> (on)	—	-0.1	-0.3	V	I <sub>O</sub> =-10mA, I <sub>I</sub> =-1mA
入力電流	I <sub>I</sub>	—	—	-3.7	mA	V <sub>I</sub> =-5V
出力電流	I <sub>O</sub> (off)	—	—	-0.5	μA	V <sub>CC</sub> =-50V, V <sub>I</sub> =0V
直流電流増幅率	G <sub>I</sub>	20	—	—	—	I <sub>O</sub> =-30mA, V <sub>O</sub> =-5V
入力抵抗	R <sub>I</sub>	—	2.7	—	kΩ	—
抵抗比率	R <sub>2</sub> /R <sub>1</sub>	0.29	0.37	0.45	—	—
利得帯域幅積	f <sub>T</sub> *	—	250	—	MHz	V <sub>CE</sub> =-10V, I <sub>E</sub> =5mA, f=100MHz

\* 構成トランジスタの特性です。

● 標準品・準標準品一覧表  
(○: 準標準品 △: 特別仕様)

Type	パッケージ	EM3		UMT		SMT	
	包装名	テーピング	テーピング	テーピング			
	記号	TL	TR	T106	T107	T146	T147
	基本発注単位(個)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
DTA1D3R		○	△	○	△	○	△

デジタルトランジスタ

PNP100mAシリーズ

## ● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

